

B-6 電場によるポリーグーベンジルーレーグルタメート液晶組織の変形挙動
(奈良女大 家政) 。松生 勝

目的 ポリーグーベンジルーレーグルタメート(PBLG)を適当な溶媒に溶解させると適当な濃度で液晶状態の液晶構造が形成される。本研究は、ニ₂液晶構造に電場を加え、この変形挙動を追跡するとともに、液晶内の分子鎖の配向もあわせ考察する。

方法 PBLGを1,1,2,トリクロロエタン(TCE)及びN,Nジメチルホルムアミド(DMA)に溶解させて、それぞれの濃度が約10%及び17%の濃厚溶液をつくり、この試料を厚さ0.2mmのセルに封入して電場を加え、セル内の液晶の変形挙動を偏光顕微鏡観察、光散乱法及び複屈折法によって考察した。

結果 PBLGをTCEに溶解して得た液晶もDMAに溶解して得た液晶も変形挙動そのものは本質的に同じであり、セルに電場を加えると、比較的低電圧領域では液晶の外形は電場方向に直角に変形し、一方液晶の内部では分子鎖の若干の運動がみられた。しかしながら高電圧になるとにつれて、この分子鎖の運動が激しくなったため、液晶の内部構造が破壊されロッドヒビゲーション分子クラスター組織に転移し、このロッドは液晶の変形方向とは逆に電場方向に優先配向した。この挙動は偏光顕微鏡下で詳細に観察され、光散乱法によっても同様に確認された。即ち、電圧を加える前の光散乱像は液晶からの散乱像を特徴づけたクローバ型4つ葉像であったが、電圧が上昇するにつれてロッドからの散乱を示唆するX字型の散乱像となつた。光軸の配向状態を示唆する複屈折値は低電圧領域でも正の値をとり、光軸は液晶の変形挙動に左右せず、常に電場方向に優先配向することが理解できた。なお、光散乱像の解析にはモデル計算を適用した。